

三菱半導体(トランジスタ) 2SB1035

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

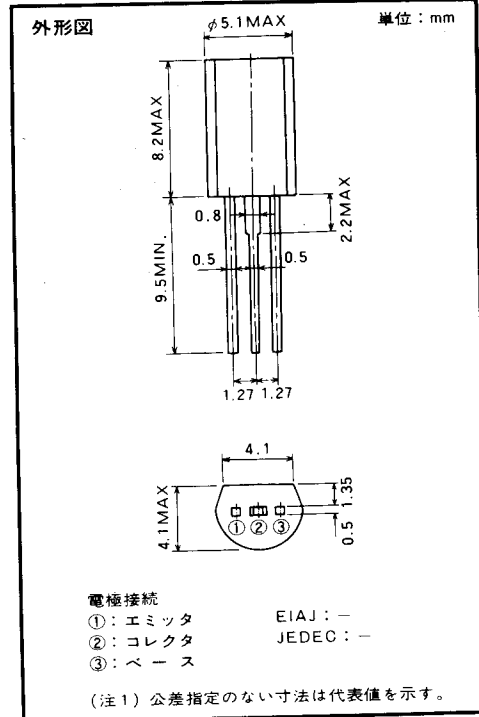
2SB1035は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、特にコレクタ損失およびコレクタ電流が大きく設計、製造されており、2~3.5W出力の低周波電力増幅用として2SD1447とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特長

- コレクタ損失が大きい $P_{Cmax}=900mW$
- コレクタ電流が大きい $I_{CM}=-1.5A$
- h_{FE} の直線性がよい
- 利得帯域幅積が高い $f_T=100MHz$ 標準

用途

ラジオ、テープレコーダ、小形ステレオ等の2~3.5W出力の低周波電力増幅回路



最大定格 (Ta=25°C)

| 記号 | 項目 | 定格値 | 単位 |
|------------------|------------------|------------|----|
| V _{CB0} | コレクタ・ベース間電圧 | -30 | V |
| V _{EB0} | エミッタ・ベース間電圧 | -4 | V |
| V _{CE0} | コレクタ・エミッタ間電圧 | -25 | V |
| I _{CM} | せん頭コレクタ電流 | -1.5 | A |
| I _C | コレクタ電流 | -1 | A |
| P _C | コレクタ損失 (Ta=25°C) | 900 | mW |
| T _j | 接合部温度 | +150 | °C |
| T _{stg} | 保存温度 | -55 ~ +150 | °C |

電気的特性 (Ta=25°C)

| 記号 | 項目 | 測定条件 | 特性値 | | | 単位 |
|----------------------|---------------|---|-----|-----|------|-----|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| V _{(BR)CB0} | コレクタ・ベース降伏電圧 | I _C =-10μA, I _E =0 | -30 | | - | V |
| V _{(BR)EB0} | エミッタ・ベース降伏電圧 | I _E =-10μA, I _C =0 | -4 | | | V |
| V _{(BR)CE0} | コレクタ・エミッタ降伏電圧 | I _C =-100μA, R _{BE} =∞ | -25 | | | V |
| I _{CB0} | コレクタしゃ断電流 | V _{CB} =-25V, I _E =0 | | | -1 | μA |
| I _{EB0} | エミッタしゃ断電流 | V _{EB} =-2V, I _C =0 | | | -1 | μA |
| h _{FE} † | 直流電流増幅率 | V _{CE} =-1V, I _C =-500mA | 55 | | 300 | - |
| V _{CE(sat)} | コレクタ・エミッタ飽和電圧 | I _C =-500mA, I _B =-25mA | | | -0.5 | V |
| f _T | 利得帯域幅積 | V _{CE} =-6V, I _E =10mA | | 100 | | MHz |

†: h_{FE}の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

| アイテム | C | D | E |
|-----------------|--------|--------|---------|
| h _{FE} | 55~110 | 90~180 | 150~300 |